



三代半-GaN产品



PGTE65R070A

1. Description

Features

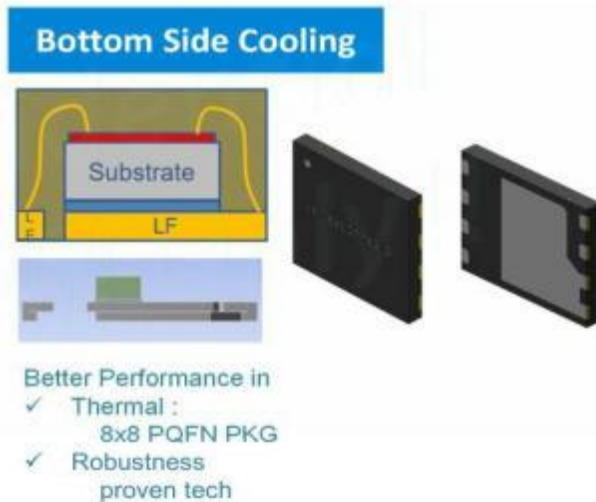
- 650V E-mode GaN FET, wafer name is PGTE65R070A

Applications

- High switching frequency converter
- High density converter

Table 1. Key Performance Parameters at $T_j = 25^\circ\text{C}$

Parameter	Value	Unit
$V_{DS, max}$	650	V
$R_{DS(on), typ.}$	65	m Ω
$Q_{IL, typ.}$	5.57	nC
I_D Continuous drain current	20.9	A
$Q_{tot} @ 400V$	46.6	nC
Q_{rr}	0	nC
$E_{rec} @ 400V$	5.96	μJ



GaN HEMT 650V 70mohm，采用DNF8*8封装
产品优良的散热设计能有效降低系统散热成本。

适用于：高功率高效率的电源，如大型服务器，
工业电源。